

中科院上海光机所光电事业部产品介绍

铝酸锂单晶对 GaN 晶格匹配非常好，因而成为潜在的 III-V 族氮化物薄膜衬底材料。

主要性能参数	
晶体结构	四方
晶格常数	a=5.17 Å c=6.26 Å
熔点 (°C)	1900
密度	2.62 (g/cm ³)
硬度	7.5 (Mohs)
与 GaN 失配率<001>	1.4%
尺寸	10x3, 10x5, 10x10, 15x15, , 20x15, 20x20, Φ15, Φ20, Φ1", Φ2", Φ2.6"
厚度	0.5mm, 1.0mm
抛光	单面或双面
晶向	<100> <001>
晶面定向精度:	±0.5°
边缘定向精度:	2° (特殊要求可达 1° 以内)
斜切晶片	可按特定需求, 加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜 (倾斜角 1° -45°) 的晶片
Ra:	≤5Å (5μm×5μm)
包装	100 级洁净袋, 1000 级超净室

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com